超高速インターネット衛星搭載用太陽電池アレイの地上放電試験*1 ESD Ground Test of Solar Array for a Wideband InterNetworking Satellite

豊田和弘^{*2}・松本利明^{*3,*4}・志方吉夫^{*5}・趙孟佑^{*6} Kazuhiro TOYODA, Toshiaki MATSUMOTO, Yoshio SHIKATA, Mengu CHO,

> 佐藤哲夫^{*7}・野崎幸重^{*8} Tetsuo SATO and Yukishige NOZAKI

Key Words: Solar Array, Substorm, Inverted Potential Gradient Conditions, Arc Discharge, Charging

Abstract: An ESD (Electro-Static Discharge) test was carried out on solar array for Wideband InterNetworking engineering test and Demonstration Satellite (WINDS). An electron beam was used to simulate the inverted potential gradient conditions. The sustained arc was not observed for test coupons with Room Temperature Vulcanization (RTV) Si grouting at the inter-string gap and thicker RTV layer between cells and Kapton sheet. Arc pulses short-circuited the PN junction of triple-junction cells once the arcs occurred at the cell edges. Effects of exposing bus bars to space without RTV coating was also investigated. There was no detrimental effect associated with the exposed bus bars.

記 与 $\phi_{\text{bias}}: P \nu 1 電位$ $<math>C_{\text{ext}}: 外部コンデンサ静電容量$ Ve: 電子ビーム加速電圧 $<math>t_{\text{exp}}: 実験時間$ $\Deltap: 放電による圧力上昇値$ I: 放電電流ピーク値 $<math>Q_{\text{ext}}: 外部コンデンサに貯えられた電荷量$ Q: 電荷量添字ave: 平均std: 標準偏差1. は じ め に

ここ十年で,静止軌道(GEO)衛星の電力レベルは10kW 近くまたはそれ以上に急激に増加した.大電力を効率良く 運用するために,衛星のバス電圧は100Vまで増加し,近 年では多くの衛星が100V発電の太陽電池アレイを採用し ている.

太陽電池アレイの発電電圧が100Vを超えるようになっ

 *1 © 2004 日本航空宇宙学会 平成16年2月18日原稿受理
 *2 千葉大学工学部
 *3 九州工業大学
 *4 現 三菱電機特機システム(株)
 *5 九州工業大学大学院

- *6 九州工業大学工学部
- *7 宇宙航空研究開発機構
- *⁸ NEC 東芝スペースシステム(株)

て,サブストーム時に太陽電池アレイ上で発生する放電現 象が,時として太陽電池アレイの安定した電力供給を脅か す深刻な問題として認識されるようになった.GEOでは, 衛星が太陽光に照らされている時,衛星の帯電現象におい ては光電子が支配的になる.強い電子フラックスの流入な どがない静かな条件下では,衛星表面が太陽光で照らされ ている限り,光電子が衛星表面から放出されることによっ て衛星電位は周辺のプラズマ電位から数 eV 以内に保たれ る.この時カバーガラスなどの絶縁体表面も衛星電位と同 様な電位を持つ.衛星がサブストームに見舞われた時,高 エネルギー電子による電流が増加し,場合によっては光電 子による電流を上回ることがある.その時,衛星構体と絶 縁体表面の電位は共に負になる可能性がある.また2次電 子放出係数の違いによって,絶縁体の表面電位は衛星構体 よりもゆっくりと負に落ちることがある.このためサブス トームの間,カバーガラスの表面電位は近くにある導体,つ まりインタコネクタよりも正になりうる.この状態を逆電 位勾配とよぶ.カバーガラスとインタコネクタの間に電位 差が生じると,放電が発生する恐れがある.

逆電位勾配は,低地球軌道(LEO)上で通常形成されて おり,カバーガラスとインタコネクタの乖離電圧が100~ 200 V に達すると,放電が発生する可能性がある¹⁾.このよ うにして発生する単発の放電を「トリガ放電」とよぶ.トリ ガ放電がアレイ自身からエネルギーを受け取り,大災害を引 き起こす放電へと成長する危険性が,衛星の電力レベルの 増加にともなって増加している.静止軌道衛星 TEMPO-2 は,1997年に厳しいサブストームに見舞われ,太陽電池ア レイの出力電力の15%以上を永久に失う事故に遭った.こ の故障は逆電位勾配下における太陽電池アレイ上での放電 によって引き起こされた²⁾.最初に,電位差のある隣り合っ た太陽電池アレイの列間で放電が発生し,2つの列は短絡 する.その時,太陽電池アレイ2列の出力電力が放電プラ ズマに供給される.放電電流は流れ続け,そのすぐ下に存 在するカプトンの絶縁層は熱的に破壊され,アレイの列と 基板の間で短絡する.本論文ではこのような放電を「持続 放電」とよぶ.

TEMPO-2の事故以来,世界中の研究機関で持続放電の 問題が調査されてきた. 趙らは技術試験衛星8型(ETS8) に搭載される太陽電池アレイの放電試験を行った3).彼ら は実験室での試験で,カバーガラスと導体という異なる2 次電子放出係数を持った部材間で,逆電位勾配が起きるこ とを実証した.その試験結果から,トリガ放電が発生する ための乖離電圧の閾値は 400 V であった.太陽電池アレイ の列と CFRP 基板の間の持続放電は,カプトンシートに傷 をつけた状態で,110Vの電位差,2.64Aの電流容量を与 えることによって発生した.この試験結果から曝露してい るカプトンシートの傷を最小限に食い止める予防策がとら れた.太陽電池セルとカプトンシートの間に塗布されてい る RTV シリコンゴム (RTV) の厚さを, 初期にデザイン されていた 50 µm から 70~100 µm へと増加させた. それ に加えて,インタコネクタ近くのカプトンシートの上にセ ルの下から RTV をはみ出させた.

豊田らは ETS8 太陽電池アレイでの放電試験の結果,ト リガ放電であっても太陽電池アレイの出力を低下させる危 険性があることを発見した4). 過度な RTV の塗布は,トリ ガ放電によってシリコン蒸気が発生することで,カバーガ ラス表面にひどくコンタミを形成する結果となった.また, セルの PN 接合が短絡し, セルが短絡することによって列 の出力電力低下が見られた. 文献 4) で発見された結果は, 単発のトリガ放電が軌道上で発生し回数を重ねていくこと で,太陽電池アレイの出力電力が徐々に減少していくこと を示唆している.これまで,GEOでのトリガ放電が電力低 下に与える影響については放電が有限のパルス幅を持って いる限り無視されてきた.もし軌道上でくり返し発生する トリガ放電が,実際に太陽電池アレイを劣化させていくと すれば,バス電圧によらずどの衛星でも逆電位勾配によっ てトリガ放電は発生するため,我々はトリガ放電による太 陽電池アレイの劣化に気付いていたはずである.

我々がそのような電力低下に気付かなかった理由として 考えられる可能性は3つある.1つには太陽電池セルへの 放射線量の影響が過大評価されていたということが考えら れる.2つめには,放射線量の影響と区別できるような影響 を与えられるまで多くのトリガ放電が,衛星寿命の期間に は発生しなかったことが考えられる.3つめには,太陽電池 アレイ面積に比例する衛星の電力レベルが低いため,各々 のトリガ放電のエネルギが電力劣化を引き起こすまで大き くなかったことが考えられる.もし3つめの仮定が正しい ならば,トリガ放電による電力低下は,近い将来,太陽電 池アレイが大型化し,カバーガラスの総静電容量が増加す



第1図 WINDS の軌道上での概念図,単位(m)

るに従って拡大するかもしれない.そのような場合,衛星 寿命期間中の電力低下を見積もり,衛星電力システムのデ ザインに反映するためのモデルが必要である.

一度,トリガ放電が発生すると,そのエネルギは衛星と 宇宙空間の間の静電容量,カバーガラスの静電容量と,2種 類の静電容量によって供給される.衛星静電容量は典型的 に 100 pF のオーダであり,トリガ放電の初期の部分を担っ ている.トリガ放電が発生した時,放電部からは電子が放 出され,負に帯電していた衛星電位は急速に0に到達する. その時,カバーガラス表面はプラズマ電位に対して正電位 になる.トリガ放電の放電プラズマは,カバーガラス表面 に貯えられた電荷を中和し,その電荷は放電電流として流 れる.したがって,カバーガラスの静電容量はトリガ放電 の規模を拡大させるという一面を担っている.近年の大電 力衛星では,カバーガラスの総静電容量は10µFかそれ以 上になる.カバーガラスと太陽電池アレイ列の間の電位差 が1kV であれば,トリガ放電に供給される静電エネルギー は1J以上になる.Leungは非常に大きな太陽電池アレイ クーポン(約30インチ四方の大きさに11×19セル)を 用いて放電試験を行った5).彼はトリガ放電による放電プ ラズマがクーポンの端まで広がり,トリガ放電発生前にカ バーガラスに貯えられた電荷量のほとんどを中和したこと を観測した.

本論文では,2005年に宇宙航空研究開発機構によって打上 げ予定の超高速インターネット衛星(Wideband InterNetworking engineering test and Demonstration Satellite: WINDS)に搭載される太陽電池アレイ上での放電試験の 結果について報告する.第1図はWINDSの概念図を示し ている.衛星に搭載される太陽電池アレイは3接合セルに よって最大55Vの発電電圧で,6kWの電力を発生する 衛星バス電圧は50Vである.放電試験の目的は以下の通 りである.

- ・耐持続放電性能の確認
- ・セル端に塗布した RTV の量がトリガ放電による電力低 下に与える影響の調査
- ・太陽電池アレイのフライトデザインの決定

WINDS の太陽電池アレイのデザインは ETS8 のデザイ ンを基本としている.WINDS は ETS8 で使用されたシリ コンセルの代わりに,3 接合セルを使用するため,カバー ガラス材質の違いが逆電位勾配下で異なる振る舞いをする ことが考えられる.また,WINDS は ETS8 とは違いイオ ン推進器を使用しないため,イオン推進器プルームからの 逆流によって生じる高密度プラズマへの電流漏洩を避ける ために,アレイ列終端の金属部(バスバー)にRTVを塗 布する必要がない、そこで静電放電に関して、むき出され たバスバーが新たな問題を引き起こさないことを確認する 必要がある.ETS84)では太陽電池アレイの電力低下が見 られたが,衛星寿命の期間内に生じる電力低下を正確に見 積もるために,電力低下についての更なる研究が必要であ る.本論文では最初に試験システムについて述べ,次に試 験結果を議論する.最後に太陽電池アレイのフライトデザ インを述べることによって結論とする.

2. 実 験

2.1 太陽電池アレイクーポン WINDS は 2 翼で 292 並列の太陽電池アレイを有しており,1並列あたり29枚の 国産の III-V 族化合物半導体製3 接合セルが直列接続され ている. 各列の出力電圧は 55 V であり, 出力電流は 0.6 A である.パドル上の列の配置により,隣り合うセル間の最 大電位差は 55 V となっている.太陽電池セルの上に接着 されているカバーガラスは Thales 社の CMG-100-AR で あり,厚みは100 μm である.カバーガラスの静電容量は 1 セルあたり約 0.76 nF であり, 片翼で約 4200 枚のセルが あることから,片翼で 3.2 μF の静電容量がある.

試験には3枚の太陽電池アレイクーポンを用いた.太陽 電池アレイクーポンの断面図を第2,3図に,クーポンの概 要を第1表に示す.3枚のクーポンはETS-8での研究成果 を反映してセルと にしているが, クー

Kapton (50µ

///////Kapton (50)

イ回路周辺の接着剤塗布量を控えめにし, クーポン1は多 めにした、クーポン2,3は列間に列間持続放電を防ぐため にRTVを塗布しているが,コンタミの発生を防ぐために RTV は絶縁を保つ必要最低限の量,つまり,セルの端を覆 い隠す程度しか塗布していない.クーポン2はバスバー上 に RTV を塗布しているが, クーポン3では塗布されてい ない.これまでの ETS-8 で開発された基本的なデザインで は、イオンエンジン排気ジェットを模擬したプラズマ環境 下においてプラズマを介在して漏洩する電流を抑制するた めにバスバー上に RTV を塗布していたが, RTV はコンタ ミの原因となり, RTV を塗布することによって太陽電池ア レイの重量も増加することから,塗布する必要がないので あればしない方が望ましい.そのためバスバーに RTV を 塗布せず,それによる不具合の可能性を調べるためにクー ポン3を用いた.

ETS-8の試験では,インタコネクタ上の放電ではなく, セル側面で放電することによってセルが破損しているのを 確認した.クーポン1ではRTV 塗布量を多めにしたため, 列間だけではなく直列セル間にも RTV がしみ出し,結果 として直列セル間が RTV で埋まったような形になった (第 3図).これによりセルと空間との絶縁が確保され,インタ

第1表 クーポン概要

Bass bar coating

Amount of RTV

、てセルとサブストレート間の接着剤層を 100 µm	1	large	yes	
	2	normal	yes	
るか,クーハノ 2,3 は E13-8 回惊众陽电心アレ	3	normal	no	
			/Interconnector	
Interconnector	\cap	\cap	\sim	
	Coveral		Coverglass (100µm))	
Coverglass (100µm)	Adhe	sive (50µm)	Adhesiye (50µm)	
Adhesive (50µm) Adhesive (50µm)	MLcel	1 (150µm)	MJ cell (150µm)	
MJ cell (150μm) MJ cell (150μm)		r (roquin)		
RTV (70~100µm) RTV (70~100µm)	RTV (70~100μm)	<u>RTV (70~100µm)</u>	
///Kapton (50µm)////////////////////////////////////	Kapid	CERP substrate	(100µm)	
CFRP substrate (100µm)				
		Aluminum honeycomb	substrate (2.5cm)	
Aluminum honeycomb substrate (2.5cm)				
		(a) 直列 方向	断面	
(a) 直列 万问断面		.		
Interstring gap		Interstring	gap	
Cover glass (100µm)	Cover gla	ass (100µm)	Cover glass (100µm)	
Adhesive (50µm)Adhesive (50µm)	Adhes	sive (50µm)	Adhesive (50µm)	
MJ cell (150µm) MJ cell (150µm)	MJ cell	(150µm)	MJ cell (150µm)	
RTV (70~100µm) RTV (70~100µm)	RTV (7	70~100μm)	RTV (70~100µm)	
Kapton (50µm)	Kapto	on (50µm)	///////////////////////////////////////	
CFRP substrate (100µm)	CFRP substrate (100µm)			

Coupon

(b) 並列方向断面

第2図 クーポン 2,3 断面図

(b) 並列方向断面

第3図 クーポン1断面図



第4図 クーポン概観

コネクタのような導体以外での放電発生を抑制し,放電に よるセル破損が抑制されることが期待される.このクーポ ンではバスバーは RTV で覆われている.

第4図に太陽電池アレイクーポンの概観図を示す.クーポ ンは厚さ 150 µm の 3 接合太陽電池セル(76 mm × 37 mm) 15枚によって構成されており,5枚のセルが直列に接続さ れたものが3列接続されている.セルの角にはバイパスダ イオードが取り付けてあり,通常ならセル自身がダイオー ドであるために発電電流が流れる向きに電流は流れないが, バイパスダイオードによってセルが発電していない場合で も電流を流すことができる.ここでは簡単のため図のよう に R, B, G とそれぞれの列に名前をつけた.また, セル には1~5と名前をつけた. R 列とB 列はクーポン裏面で 並列に接続されており,これらのセルは試験中必ず同一の 電位を持つことになる. セルは厚さ 50 µm のカプトンフィ ルムの上に接着されている.カプトンフィルムは,アルミ ハニカム(厚さ 25 mm)の上に貼付けられた CFRP シー ト(厚さ 0.1 mm)の上に貼付けられている.クーポンの 側面は全てカプトンフィルムによって覆われている.太陽 電池アレイの各列はバスバーを介して裏面のコネクタに接 続されている.太陽電池アレイは,コネクタに接続された ケーブルによって真空タンクの高電圧電流導入端子を介し て外部回路へと接続されている.

全てのクーポンは出荷前に工場で,フライト用の太陽電 池パネルに対して実施するものと同一の条件でベーキング が施されている.工場から研究室への出荷にあたり,アレ イ表面には特別な処理は施されていない.全てのクーポン には大気中から真空タンク内に設置され真空排気後に必ず $70 \pm 1^{\circ}$ Cで2時間ベーキングが行われており,真空タンク から取り出された後,顕微鏡撮影後に電気性能試験のため 工場へ送られる.試験中は $40 \pm 1^{\circ}$ C に保たれている.

2.2 測定系 第5図に測定系の概念図を示す.太陽電池 アレイは直径 $0.6 \,\mathrm{m}$, 長さ $0.9 \,\mathrm{m}$ の真空タンク内に,セル面 を上にしてアクリル板の上に配置されている.クーポンは真 空タンクとは電気的に絶縁されている.真空タンクはターボ ポンプによって真空排気されており,試験前は $10^{-5} \,\mathrm{Pa}$ まで 排気することが可能である.また,試験中は約 $1 \times 10^{-3} \,\mathrm{Pa}$ 前後であり,中性粒子密度は約 $2 \times 10^{17} \,\mathrm{m}^{-3}$ 程度である.



第5図 測定系概念図



第6図 実験回路

クーポンの真上には電子ビーム銃(ULVAC RHEED)が 取り付けられており,照射される電子ビームの中心とクー ポンの中心は一致している.最大 30 keVの電子を照射す ることが可能で,実験で主に使用された 3 kVのビームエ ネルギーでは,電子ビームはクーポン上で電流密度のピー ク値が約 10 mA/m^2 で直径約 150 mmのガウス分布をし ている.

XY ステージには表面電位プローブ(Trek probe, Model-341)が取り付けてあり, クーポン表面の電位分布の2次元 計測が可能である.この表面電位計は ±20 kV まで測定可 能である.プローブはクーポンから5mmの距離を保って 移動する.第4図に示した180×140mmの領域を10mm 間隔で計測した.計測は,ステージの制御およびデータ取 得をPCで自動制御することによって行われ,1回の計測 に約7分を要する.

放電は放電位置特定システムによって測定された.この システムでは,CCD カメラにより撮影されるアナログ信 号は AD コンバータによってデジタル動画ファイルとして PC に接続されたハードディスク内にリアルタイムに保存 され,実験後にコンピュータプログラムによって放電位置 が特定される⁶⁾.

2.3 実験回路 第6図に実験回路を示す.太陽電池アレイから外部回路へは真空タンクに取り付けられた高圧電流 導入端子を介して接続されている.太陽電池アレイは高圧 電源(Glassman EW 60 kV)によって負にバイアスされて おり,放電電流が直接電源に流入するのを避けるため,太陽 電池アレイと電源の間には10 M Ω の制限抵抗が接続されて いる.この制限抵抗の直後には高電圧プローブ(Tektronix P-5100)が接続され,アレイ電位 ϕ_{bias} を測定することが できる.R, B列とG列, 基板の間には, 発電時の列間電 位差を模擬するために直流電源(Takasago GP110-5R)が 接続されており, 通常は55Vの電位差を持った定電圧電源 として動作し, B列とG列が短絡した場合には1.0Aの定 電流電源として動作する.

放電電流はそれぞれの位置で測定され,図中の CP_RB と CP_total は直流成分から 10 MHz までを測定可能な電流 プローブ(HIOKI 3274)を用い,CP_G,CP_frame には 8.5 kHz から 100 MHz まで測定可能な電流プローブ(Tektronix P6022)を用いた.電流プローブと高電圧プローブは 2 台の4 チャンネルオシロスコープ(Tektronix TDS224, 100 MHz)に接続されおり,高電圧プローブによって測定さ れるアレイ電位の放電による上昇をトリガとして放電波形 が測定される.オシロスコープの放電波形データは GPIB ケーブルを介して,順次 PC に取り込まれる.

回路には放電プラズマによって取り込まれるカバーガラ スの帯電電荷量を模擬するために,外部コンデンサが接続 されている.この外部コンデンサの容量は,放電発生時に カバーガラスに貯えられている静電エネルギーと同程度に 設定するため,放電発生に必要な乖離電圧の閾値を測定す る必要がある.そのため,乖離電圧の放電閾値測定後にコ ンデンサ容量を決定した.放電閾値測定については2.4 で 詳しく述べる.

2.4 放電閾値決定方法 外部コンデンサの容量を決定 するために, 乖離電圧の放電閾値を測定した. 第7図に電 子ビームによる帯電放電の模式図を示した、プラズマを生 成することによってカバーガラス表面の電荷を除電した太 陽電池アレイにエネルギーが一定の電子ビームを照射する と,図のようにあるカーブを持ってカバーガラスの電位は 上昇していく.このカーブは電子ビームのエネルギーと電 流密度を一定にした場合には等しくなる.電子ビームを照 射してから時間 Δt 後, カバーガラスの乖離電圧 ΔV が ある値になると放電が発生し,カバーガラスの帯電電荷の 大部分が放電プラズマに取り込まれ乖離電圧はほぼ0に戻 る.放電が起きている最中にも電子ビームは照射され続け ているため,カバーガラスは再び帯電し,乖離電圧が上昇 する.放電が発生してから次の放電が発生するまでの時間 が最小になる時に放電に必要な乖離電圧も最小となるため, 放電閾値は ΔVmin となり,放電後カバーガラスの電位が0 になった状態から電子ビームを照射することによって乖離 電圧 ΔV_{\min} を生み出すのに必要な時間は Δt_{\min} となる. 放電閾値測定ではまず,太陽電池アレイを-3kV にバイア スし,3keVの電子ビームを1時間照射することによって



第7図 電子ビーム照射による帯電放電の模式図

複数回の放電を発生させ,放電間の最小時間 Δt_{\min} を測定した.その後ビーム照射を行って,放電が発生してから Δt_{\min} 後に電子ビーム照射を止め,カバーガラスの表面電 位分布を測定することにより放電閾値を求めた.

放電閾値測定にはカバーガラスが WINDS に使用される ものと等しいクーポンを使用した.クーポンを-3 kV にバ イアスし、100 nF の外部コンデンサを接続した.3 keV の 電子ビームを1 時間照射し,複数の放電を発生させたとこ ろ,放電間の時間間隔の最小値 Δt_{\min} は4秒であった.次 に電子ビームを照射し,放電が発生してから4秒後に電子 ビーム照射を止め、カバーガラスの表面電位分布を測定し た.その結果を第8 図に示す.図に示した×印は Δt が4 秒であった2回の放電位置を示しており、いずれの放電もイ ンターコネクタ上で発生した.インターコネクタの電位は バイアス電圧と等しいため、放電発生箇所の乖離電圧は低 くなっている.実際に放電を発生させる要因となった放電発 生点周辺のカバーガラス上の乖離電圧の最大値は約800 V であった.これにより乖離電圧の閾値 ΔV_{\min} を800 V に 定めた.

放電直前にカバーガラスに貯えられている電荷の静電エ ネルギー U_{cg} は,式 (1)のように表される.

$$U_{\rm cg} = \frac{1}{2} C_{\rm cg} \Delta V_{\rm min}^2 \tag{1}$$

ここで C_{cg} は全てのカバーガラスの総静電容量である. WINDS では片翼で約 4 μ F の静電容量があり,実験により求められた 800 V の ΔV_{min} を用いると,式(1)より静電エネルギーは 1.28 J となる.この結果から放電試験では放電へ供給される静電エネルギーが 1.28 J に近くなるように,外部コンデンサの静電容量を決定した.

試験では-3,-4,-6 kV のバイアス電圧を用いた.試験によってバイアス電圧が異なるため,静電エネルギーを同程度にするために静電容量も変える必要がある.そこで,それぞれ400,200,100 nF とした.これによって静電エネルギーはそれぞれ1.8,1.6,1.8 J となる.



第8図 放電後4秒後のカバーガラスの乖離電圧測定結果

おとな、大歌ホロ						
Case	Coupon	ϕ , -kV	$C_{\rm ext},{\rm nF}$	V_e , kV	$t_{\rm exp}$, hour	
1	1	3	400	$2.8 \thicksim 4.0$	6	
2	1	4	200	$3.0 \sim 4.0$	4	
3	1	6	100	$3.0 \sim 6.0$	10	
4	2	3	400	$2.8{\sim}4.0$	6	
5	2	4	200	$3.0 \sim 4.0$	4	
6	2	6	100	$3.0 \sim 6.0$	10	
7	3	3	400	$2.8 \thicksim 4.0$	6	
8	3	4	400	$3.0 \sim 4.0$	4	
9	3	6	100	$3.0 \sim 6.0$	10	
10	3	3	400	$2.8 \sim 4.0$	6	
11	3	4	200	$3.0 \sim 4.0$	4	
12	3	3	400	$3.0 \sim 4.0$	35	

筆りま 宝齢冬件

2.5 実験条件 放電閾値測定結果に基づき,宇宙機帯 電解析ソフト NASCAP/GEO を用いて衛星表面電位が逆 電位勾配になる時間を計算した結果,予定運用期間5年間 で約60時間であった7).そこで放電によるセルの電力低下 を評価するため, クーポン3の試験時間を65時間に設定し た.第2表に試験条件を示す.実験には Case 1 から 12 の 名前をつけた.クーポン1および2ではそれぞれ合計20時 間の実験を行い、クーポン3では合計65時間実験を行った。 Case 1 から Case 9 および Case 12 では電子ビームの中心が クーポンの中心にくるように設定されているが, Case 10, 11 では B 列 No.1 セルの中心に設定されている.これは, バスバーとインタコネクタの放電発生頻度の違いを見るた めの実験では,インターコネクタと同程度にバスバー付近 のカバーガラスを帯電させる必要があったため,電子ビー ムの中心をバスバーよりにずらし,バスバー付近での電子 ビーム電流密度を増加させる必要があったためである.電 子ビームの加速電圧 V_e は放電を起きやすくするために試 験中徐々に減少させていった.バイアス電圧は一定時間ご とに変化させ, ϕ_{bias} が放電に与える影響を調べた.Case 8では 200 nF の外部コンデンサが使用される予定であった が,誤って 400 nF のものを使用した.

クーポンは Case 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 の終了後に 真空タンクから取り出され, クーポン表面の顕微鏡撮影の 後,工場へ輸送され電気性能を取得された.クーポンは一 度真空タンク内に配置されると, 3 日程度真空中に置かれ ていることになる.大気中からクーポンを真空タンクへ入 れ,真空排気をした後には必ず 70°C の温度で 2 時間ベー キングを行った.実験中, クーポンは 40°C に保たれ,真 空タンク内の圧力は $0.5 \sim 5 \times 10^{-3}$ Pa であった.

3. 結果および考察

3.1 放電回数,位置 第3表に放電発生回数を示す.各 クーポンの20時間試験後の合計回数はクーポン1が298 回,クーポン2が392回,クーポン3が266回となって いる.クーポン1とクーポン3は300回程度と同程度で あるが,クーポン2は他のクーポンより放電が多く発生し ている.クーポン3のCase10,11でも10時間で270回 と多くなっており,どちらの場合も実験中の真空タンク内 の圧力が他の場合に比べて高くなっている.このことから,

第3表 放電発生回数							
Case	Coupon	$N_{\rm arc}$	$t_{\rm exp}, h$	$p, 10^{-3} \text{Pa}$			
1	1	88	6	1.12			
2	1	78	4	1.25			
3	1	132	10	0.98			
4	2	58	6	1.10			
5	2	1	4	0.65			
6	2	333	10	2.46			
7	3	60	6	0.86			
8	3	41	4	0.62			
9	3	165	10	0.83			
10	3	150	6	2.51			
11	3	120	4	1.73			
12	3	84	35	0.56			



Case 4,6 と Case 10,11 で放電が多く発生したのは真空 タンク内の圧力が高かったためと思われる.クーポン3で は65時間の試験で合計610回の放電が発生した.これだ け多くの放電が発生したが,列間および列基板間の持続放 電が発生することはなく,これらのデザインの高い耐持続 放電性能が確かめられた.

第9図に実験後に測定したクーポン上の乖離電圧分布

測定結果の例を示す. Case 2の乖離電圧分布は, ϕ_{bias} が $-4\,\mathrm{kV}$, V_e が $3\,\mathrm{kV}$ であり, Case 3 では ϕ_bias は $-6\,\mathrm{kV}$, Ve は 3.4 kV である. どちらの場合も 1 kV 以上の乖離電圧 になっているが,分布が異なっている.Case2では1kV以 上の部分が,クーポンの中心に設定されている電子ビーム 照射の中心付近が最も良く帯電しており,1kV以上帯電し ている部分が多く,円状に分布している.この場合,クー ポンは -4 kV にバイアスされ 1 kV 以上帯電しているため, カバーガラスの表面電位は -3 kV 以上になっている. その ため,3kV で加速された電子ビームはカバーガラスからの 電界によって減速されるが,カバーガラスに到達すること はできるため,この場合は2次電子による正帯電といえる. また,この場合電子ビームの電流密度は数 mA/m^2 である. しかし, Case 3 ではクーポンが $-6 \,\mathrm{kV}$ にバイアスされて いるため,カバーガラスの表面電位は1.5kV 帯電したと しても -4.5 kV となり, 3.4 kV で加速された電子ビームは カバーガラスに到達することができない.そのため,この 場合は2次電子による帯電ではなく,電子ビームによって 中性粒子が電離した正イオンによって帯電していると思わ れる.

第10 図に放電発生位置分布を示す.放電の大部分がイ ンタコネクタ上で発生しており,導体が空間にむき出しに なった部分で放電が発生しやすいことがわかる.Case2と Case3を見ると,第9図の帯電分布と放電発生位置がよ く一致している.Case4~6では他のケースでは放電が見 られなかったセルの端の部分で放電が発生している.また, Case10~12でもインタコネクタ以外のセルの端でも放電 が発生している.

第11 図に放電電流波形の例を示す.これは Case 1 の実 験中に B 列のインタコネクタ上で起きた放電電流 *CP*total の波形である.パルス幅は 30 µs 程度である.このような 電流波形から放電電流のピーク値と放電電荷量を計算する. また放電発生時には放電痕近くの表面材が蒸発し,これに よって上昇する真空タンク内の圧力を電離真空計により測 定している.

第4表に電流ピーク値,放電電流電荷量($Q = C_{\text{ext}}\phi_{\text{bias}}$) および放電による圧力上昇の試験結果を示した.表にはそ れぞれの平均値,標準偏差が示してある.クーポン2を用 いた試験では直流成分に近い電流波形を測定できるプロー プを用いておらず,正しく電流値を測定することができな かったため,Case4~6の結果は示されていない.放電電 流の平均値は外部コンデンサに貯えられた電荷量が大きく なるにつれて,増加する傾向にある.クーポン1とクーポ ン3を比較するとQが等しい場合には,標準偏差を考慮す るとどの値も同程度であり,クーポンによる放電の違いは 見られない.

3.2 発電電力低下 試験後,全てのクーポンで発電電 力の低下が見られた.第12図に最大発電電力の初期状態 からの劣化量を示した.図の横軸は放電回数を示している. R列とB列はクーポンの裏面で並列に接続されているた め,電気性能測定の際に分離はしていない.最も劣化の激



第11図 放電電流波形

Case	Q, mC	$I_{\text{ave}}, \mathbf{A}$	$I_{\rm std},{\rm A}$	$Q_{\rm ave},{\rm mC}$	$Q_{\rm std},{ m mC}$	$\Delta p_{\rm ave}, {\rm mPa}$	$\Delta p_{\rm std},{\rm mPa}$
1	1.2	123.5	50.8	1.12	0.23	1.32	0.14
2	0.8	105.5	49.0	0.80	0.06	1.15	0.08
3	0.6	81.6	33.1	0.64	0.04	0.966	0.08
7	1.2	151.5	108.7	1.22	0.22	1.38	0.14
8	1.6	159.4	65.1	1.56	0.16	2.06	0.11
9	0.6	71.2	27.0	0.63	0.02	0.94	0.09
10	1.2	144	66.5	1.27	0.13	1.53	0.15
11	0.8	111	69.5	0.80	0.01	1.12	0.10
12	1.2	155	59.9	1.27	0.13	1.60	0.19





第12図 放電による電力低下

しかったものがクーポン2のR,B列であり,59回の放電 で23%,392回の放電で49%の電力低下が見られた.クー ポン1では156回の放電で19%の劣化が見られた後,288 回の放電発生後に更に劣化することはなかった.また,クー ポン3では266回の放電ではほとんど劣化は見られないが, その後610回の放電で47%と著しく劣化していた.これら のことから,電力低下は単調に放電回数によって増加して いくという訳ではなく,セル破損を引き起こす放電が存在 し,その放電が発生した時に電力が低下するものと考えら れる.

クーポン2において破損しているセルの特定を行った. その結果, B列のセル2,4とR列のセル3が短絡状態に なっており,電力を供給できない状態になっていた.この 結果から400回の放電により3枚のセルが破壊される可能 性があることがわかる.NASCAP/GEOを用いた解析結 果によると予定運用期間5年間で14950回の放電が発生す ると予想される⁷⁾.これらの結果から5年間で約112枚の セルが破壊されると見積もることができる.

次に B 列のセル4 に,赤外レーザ照射によって変化する 抵抗値を測定することにより電流漏洩箇所を特定する IR-OBIRCH 法⁴⁾を用い電流漏洩箇所を特定した.その結果, セルの端で PN 接合が短絡していることがわかった.短絡 箇所の顕微鏡写真を第13 図に示す.短絡が起きたセル4 に は銀色の放電痕が付着していた.また,放電は RTV に穴 が開いている部分で発生しており,ここではセルの端が空 間にむき出しになっている.このような穴で放電が発生す るとセルの短絡が発生しやすくなると思われる.穴はクー ポンの製作工程上発生を抑えることは困難であり,穴が開 いている部分に RTV を上塗りすることで穴を塞ぐことが 可能であるが,実際の太陽電池アレイでは 8000 枚以上の



第13図 B列電流漏洩箇所の顕微鏡写真



第14図 クーポン3のR列でセル短絡を引き起こしたと 思われる放電痕

セルが貼付けられることから,完全に穴をなくすことは難しい.また,クーポン2ではこのような穴が最も多く存在していた.

第14 図にクーポン 3 の Case 10 において R 列のセルの 端で放電が発生した部分の顕微鏡写真を示す.図ではセル 4 の端に 2 箇所放電痕があるのがわかる.この放電痕のつ き方は第13 図のリークと似ており,この放電痕がセルを短 絡させたと思われる.しかし,第14 図ではセルの端に第 13 図で見られたような RTV にあいた穴は見られなかった. この他にも G 列のセル端で放電が発生し,同様の放電痕が セルの端についているのが確認でき,この場合にも RTV の穴はなかった.これらの結果から RTV の穴がある場合 にはセル端での短絡は発生しやすいが,RTV の穴がないセ ルの端で放電が発生した時にもセルでの短絡は起きること がわかった.このため,RTV の有無によらず,セル端での 放電によるセルの破損を完全に防ぐことは困難であると思 われる.

3.3 バスバー上の RTV 塗布の有無による影響 クー ポン3を用いた最初の 20 時間の試験では,電子ビーム照射

第5表 放電発生位置による放電諸量の違い

Case	Position	$I_{\text{ave}}, \mathbf{A}$	$I_{\rm std},{\rm A}$	$C_{\rm ave},{\rm mC}$	$C_{\rm std},{\rm mC}$
10	Bus bar	122	36	1.23	0.08
10	IC	128	34	1.24	0.09
11	Bus bar	91	37	0.79	0.05
11	IC	88	24	0.75	0.04

の中心がクーポンの中心に設定されているためにバスバー 近傍は中心に比べてあまり帯電せず,バスバー上での放電 はあまり発生していない.そこで電子ビーム照射の中心を バスバーよりにずらすことによって,バスバー近傍をイン タコネクタと同程度に帯電させ,バスバーがインタコネク タと比べて放電が発生しやすいかどうかを調べた.もし, RTV を塗布せず空間に対して曝露したバスバーでの放電 発生頻度が他の場所に対して高ければ,バスバーを放電に 対する避雷針代わりに利用し,セル劣化が発生しやすいセ ル端での放電発生頻度を抑えることができる.また,バス バーに RTV を塗布しないことによって持続放電などが起 きなければ,バスバーに塗布する RTV の重量を衛星全体 で数 kg 程度削減することができ,WINDS の重量設計に 対する余裕ができるという利点もある.

電子ビーム照射の位置をずらして 10 時間,それ以前の 20 時間を合わせて 30 時間で,むき出しになったバスバー で発生した放電によって持続放電が発生することはなく, バスバーに RTV を塗布する必要はないことがわかった. Case 10,11 の 10 時間の試験でバスバー上では 121 回,そ れ以外では 137 回の放電が発生した.この結果から曝露さ れたバスバーは他の部分に比べて特別放電が発生しやすい ということはないということがわかった.しかし,バスバー で放電が発生することによりカバーガラス上の帯電電荷が 取り込まれ,乖離電圧が 0 付近に減少するため,他の部分 で放電する確率は減少し,セル破損が発生しやすいセル端 での放電の発生確率も減少する.そのため,バスバーを暴 露することは,セル劣化を防ぐには間接的ではあるが有効 な手段であると思われる.

第5表にバスバーおよびインタコネクタ上で発生した放電 の放電電流ピーク値,電流電荷量を示した.電流値も電荷量 もバスバーとインタコネクタによる違いは見られなかった.

これらのことからバスバーに RTV を塗布する必要はな いと判断した.

4. ま と め

WINDS に搭載する太陽電池アレイの地上試験を行った. 試験に際しては3種類の異なるデザインのクーポンを用いた.その結果,全てのクーポンが列間および列基板間での持続放電に耐えることができた.しかし,全てのクーポンでセル劣化が見られた.セル劣化はセル端で発生した放電によって引き起こされ,セル端が空間に露出されている場合は劣化しやすいことがわかった.しかし,セル端がRTVで覆われている場合にもセル劣化を引き起こす放電は発生しており,RTVによって完全にセル端で放電を抑制することは困難である. バスバーに RTV を塗布しないことによって,放電によっ て不具合が起きることはなかった.そのため,セル劣化を 引き起こすセル端での放電を間接的に防ぐ,また,RTV 重 量を低減するためにもバスバーに RTV を塗布しないほう がよい.

これらの結果から WINDS に搭載する太陽電池アレイの 最終的なデザインを決定した.このデザインを次に示しま とめとする.

- ・列間持続放電を抑制するため,並列列間には RTV を塗 布する.
- ・列基板間持続放電を抑制するため,インタコネクタのあ る直列列間のカプトンシート上も RTV で覆い,さらに 絶縁性を増すためにセル基板間の RTV の厚さを 100 µm 程度とする.
- ・セル端での放電を防ぐため、RTV に開いた穴はRTV を
 上塗りすることによって極力減らす。
- ・バスバーには RTV を塗布しない.

今回の試験では, 文献 4) で見られたシリコンセルの放 電による電力低下と同様に, 化合物半導体 3 接合セルにお いても放電によってセルが破壊されることが確かめられた. また, セル端で発生した放電がセル劣化を引き起こすこと がわかった.しかし, セルを破壊するのに最低必要な放電 の規模を知るまでには至っていない.今回の試験では, 太陽 電池パドル全体に蓄えられた静電エネルギーが放電発生時 に放電に供給されると仮定しており, ワーストケースを想 定した試験である.今後はセル破壊を引き起こす放電エネ ルギーの閾値を調べる必要があり, そのようなエネルギー が現実に放電に供給されうるかを検討しなければならない.

九州工業大学の匹田政幸教授,宇宙航空研究開発機構の 高橋真人様,川北史朗様,中村雅夫様に感謝いたします.

参考文献

- 1) Hastings, D. E. and Garrett, H.: Spacecraft-Environment Interactions, Cambridge Univ. Press, New York, 1996.
- Katz, I., Davis, V. A. and Snyder, D. B.: Mechanism for Spacecraft Charging Initiated Destruction of Solar Arrays in GEO, AIAA Paper 98-1002, 1998.
- 3) Cho, M., Matsumoto, T., Ramasamy, R., Toyoda, K., Nozaki, Y. and Takahashi, M.: Laboratory Tests on 110 V Solar Arrays in a Simulated Geosynchronous Orbit Environment, J. Spacecraft Rockets, 40 (2003), pp. 211–220.
- Toyoda, K., Matsumoto, T., Cho, M., Nozaki, Y. and Takahashi, M.: Power Reduction of Solar Arrays Due to Arcing under Simulated GEO Environment, AIAA Paper 2003-0682, 2003.
- 5) Leung, P.: Plasma Phenomena Associated with Solar Array Discharges and Their Role in Scaling Coupon Test Results to a Full Panel, AIAA Paper 2002-0628, 2002.
- 6) Toyoda, K., Cho, M. and Hikita, M.: Development of Position Identification System of Arc Discharge on a Solar Array in Vacuum by Digital Processing of Video Images, J. Jpn. Soc. Aeronaut. Space Sci., 51 (2003), pp. 82–84.
- 7) Sato, T., Takahashi, M., Nakamura, M., Kawakita, S., Cho, M., Toyoda, K. and Nozaki, Y.: Development of Solar Array for a Wideband Internetworking Engineering Test and Demonstration Satellite, 8th Spacecraft Charging Technology Conference, Huntsville, USA, 2003.